

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Жерихов Егор Петрович

студент

Беспалов Владимир Александрович

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой

ФГАОУ ВО «Национальный

исследовательский университет

«Московский институт

электронной техники»

г. Москва

МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ КМОП ИС

***Аннотация:** в последнее время в современном мире микроэлектроники прослеживаются две ключевые тенденции: увеличение быстродействия и снижение энергопотребления. Создание электронных устройств с большей вычислительной мощностью и малым энергопотреблением, позволяет нам использовать более компактные приборы, работающие на аккумуляторах или батареях. Тенденция разработки новых приложений, программ и ПО неуклонно растет, тем самым удовлетворяя желания потребителей, а между тем различные инновации и нововведения требуют все больше энергии, тем самым уменьшая время работы портативных устройств. Как пример мы можем сравнить время работы мобильного телефона в 2000 году и 2014 годы, или же время работы современных смартфонов на различных операционных системах. Развитие старых, и разработка новых методов снижения энергопотребления, актуальные темы для исследования в мире микроэлектроники, поскольку чем энергоэкономичнее будут современные приборы, тем дольше и быстрее они смогут работать.*

***Ключевые слова:** уменьшение энергопотребления, КМОП структура, FinFET технология, VTSMOS технология.*

На данный момент не найдено универсальное решение, которое решило бы данную проблему во всех возможных ситуациях. По этой причине нужно учитывать особенности проектируемых устройств, такие как быстродействие, надежность, затраты на создание и т.п.

Рассмотрим основные методы, которые могут использоваться комплексно или в отдельности для минимизации энергопотребления при проектировании КМОП ИС.

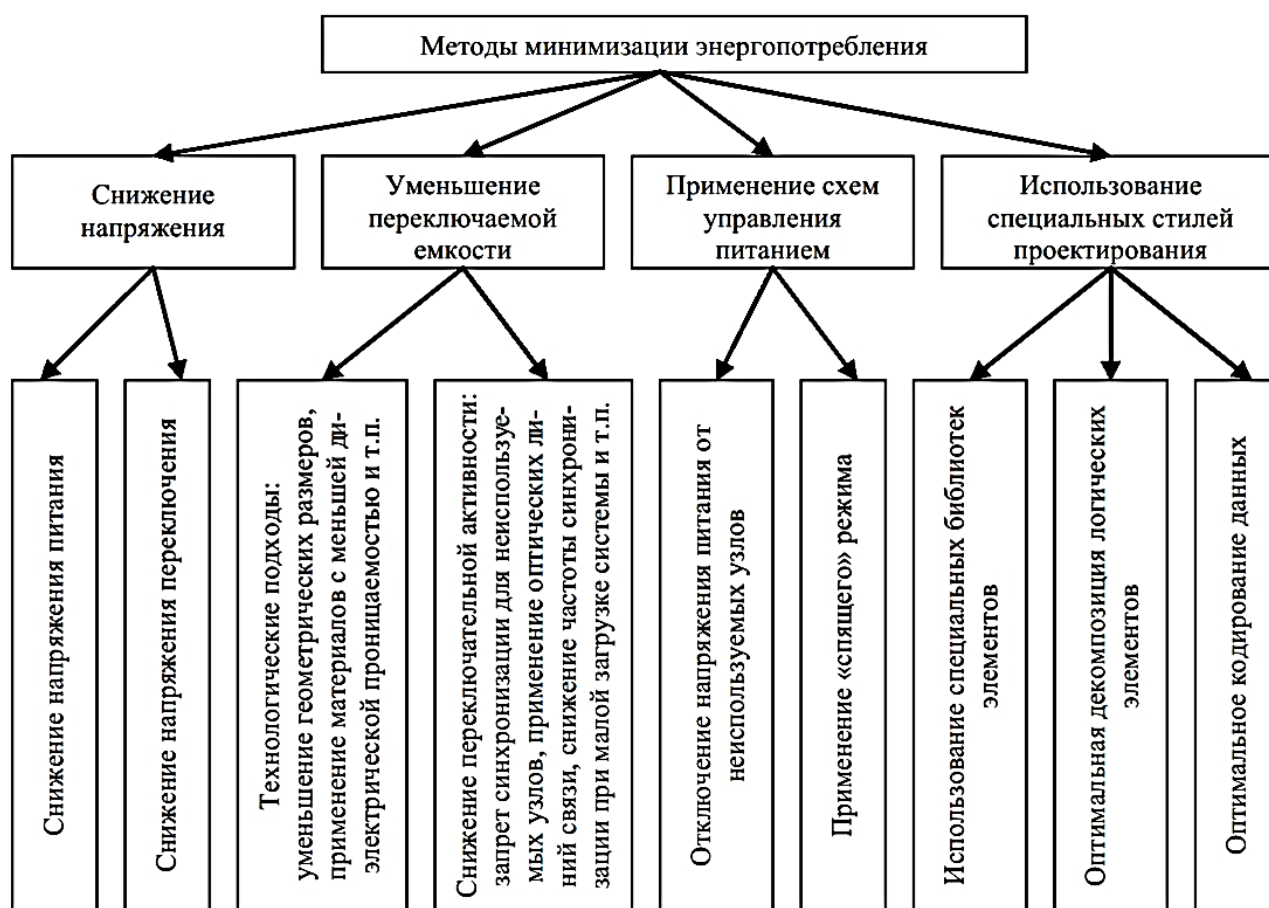


Рис. 1. Классификация методов минимизации энергопотребления при проектировании КМОП ИС

На рисунке 1 представлена обобщенная классификация основных используемых методов минимизации энергопотребления. При традиционных КМОП-технологиях (минимальные размеры элементов не переходят в субмикронную об-

ласть) основную долю рассеиваемой мощности составляет динамическая мощность. Снижение любого параметра: напряжения питания, напряжения переключения, перезаряжаемой емкости или частоты переключения- приводит к уменьшению величины рассеиваемой мощности.

Обычно наибольшее внимание инженеров направлено на уменьшение величины напряжения питания. Это связано с тем, что для большинства КМОП ИС напряжение питания равно напряжению переключения. Между динамической рассеиваемой мощностью и напряжением питания ИС существует квадратичная зависимость. Помимо этого, при уменьшении напряжения питания одновременно уменьшается и статическая мощность.

При анализе энергопотребления КМОП ИС выделяют две основные составляющие энергопотребления: статическая и динамическая. Статическая составляющая включает в себя следующие различные компоненты: токи, связанные с туннелированием, токи утечек через р-n переходы, подпороговые токи утечки. К динамической составляющей относятся следующие эффекты: перезарядка емкостей схемы и сквозные токи в процессе переключения узлов схемы. Общее потребление КМОП ИС можно представить в виде следующего выражения:

$$P = C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot \alpha_T \cdot f + V_{dd} \cdot I_{sc} + V_{dd} \cdot I_{leak} \quad (1)$$

где P – общая потребляемая мощность, C_L – нагрузочная емкость, V_{dd} – напряжение питания, α_T – активность переключений, f – тактовая частота, I_{sc} – сквозной ток, I_{leak} – суммарный ток утечки.

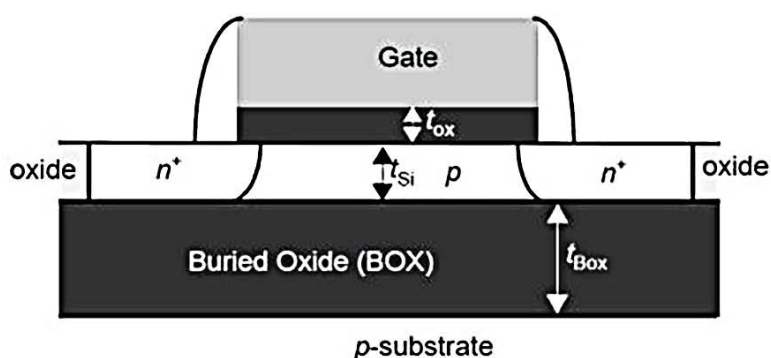
Следующим фактором, влияющим на величину динамической мощности, является частота переключения, поэтому ее снижение также будет приводить к снижению рассеиваемой мощности. Однако при этом возникает конфликт с требованиями, касающимися производительности. Для устранения этого конфликта можно использовать различные подходы. Во-первых, при проектировании новых устройств приоритет должен отдаваться решениям с пониженными требованиями к рабочей частоте функциональных компонентов. Во-вторых, для снижения тактовой частоты необходимо применять методы параллельного выполнения операций на конвейере. В-третьих, целесообразно использовать различные

схемы запрета синхронизации как для неиспользуемых функциональных модулей, так и для модулей или компонентов, информация в которых не изменяется в данный момент. Например, при проведении целочисленных вычислений обычно не используются узлы сопроцессора, которые предназначены для вычислений с плавающей запятой, поэтому на эти узлы в данный момент импульсы синхронизации поступать не должны.

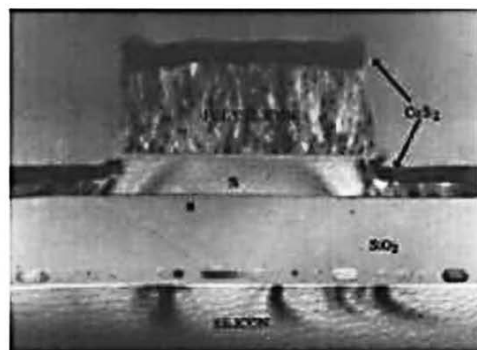
Снижение энергопотребления на технологическом уровне

В современных технологиях, начиная с уровня 0,18 мкм КМОП, имеется возможность изготовления МОП-транзистора с двумя значениями порогового напряжения, что обеспечивает совместимость с методом множественных пороговых напряжений на функционально-логическом уровне.

В настоящее время все более широко применяется технология Silicon-on-insulator (SOI). Структура МОП-транзистора, изготовленного по технологии SOI приведена на рисунке 2.



(а)



(б)

Рис. 2. Структура КМОП SOI: а) схематическое изображение структуры транзистора; б) полученный с помощью сканирующего электронного микроскопа вид поперечного сечения.

За счет уменьшения емкостей SOI МОП-транзистора удастся уменьшить потребляемую мощность, задержки и занимаемую площадь. При переходе к наноразмерным топологическим нормам также успешно используются технологии на объемном кремнии и SOI. Особый интерес представляет разновидность транзистора с двойным затвором – FinFET транзистора. В этом приборе тонкая кремниевая структура (столбик, вставка – fin) «обернута» затвором. Выступающая передняя область тела – исток транзистора, выступающая задняя область – сток. Ток протекает в плоскости, параллельной плоскости структуры. Активная ширина прибора равна высоте столбика, и ее можно увеличивать путем параллельного включения многих столбиков. По своей топологии FinFET не отличается от традиционного МОП- транзистора, за исключением того, что активная область формируется вставками, а не представляет собой плоский прямоугольник. Появилась структура трехзатворного FinFET (рисунок 3).

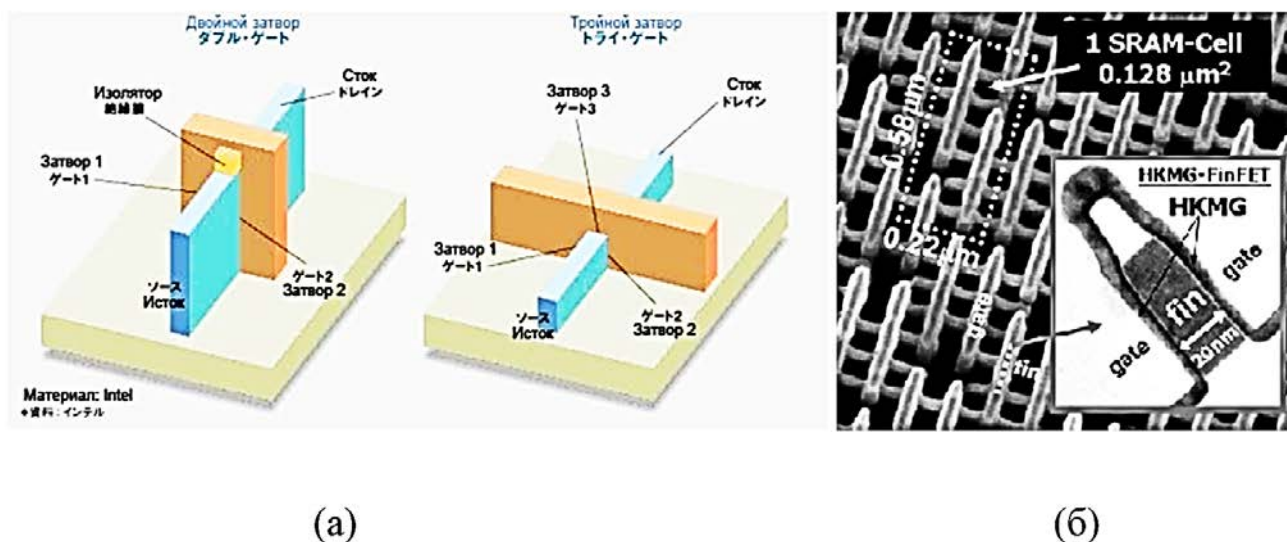


Рис. 3. Структура FinFET: а) структура FinFET б) FinFet SRAM

При переходе к 45нм топологическим нормам для создания затворов транзисторов с малыми токами утечек использован новый материал для диэлектрика – так называемый high-k диэлектрик, в сочетании с новым материалом для электрода затвора транзистора на основе металлов.

Рассмотрим влияние различных технологических базисов на величину энергопотребления, разработанного 5-ти разрядного таймера. Для сравнения выбраны технологии HCMOS-0.18um, CMOS-0.35um и AMS-0.6um. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты расчета мощности таймера в различных тех. базисах

Технология	HCMOS 0.18 (Vdd=2 v; L=0.18u)	CMOS 0,35u(Vdd=3.5B; Wn=0.8u; Wp=3.2u;Cn=3p; Vtn=0.6, Vtp=-0.6 Kn=200 Kp= 52 Tox=7)	AMS 0.6 (Vdd=5; Vtn=0,8; Vtp=-0,9; Kn=140; Kp=42; Wn=0.9; Wp=3)
P_{inv}, BT	3,40E-07	4,23E-06	9,18E-06
P_{2and}, BT	4,64E-07	5,07E-06	1,13E-05
P_{3and}, BT	5,90E-07	5,92E-06	1,34E-05
P_{device}, BT	9,71E-04	3,56E-03	7,41E-03

Снижение энергопотребления на схемотехническом уровне

На схемотехническом уровне можно выделить несколько вариантов построения энергоэффективных решений: статическая КМОП логика, динамическая логика, логика на проходных транзисторах, адиабатическая логика, псевдо n-МОП логика, схемы с переменным пороговым напряжением, схемы с дополнительным источником питания, использование управления по дополнительным затворам.

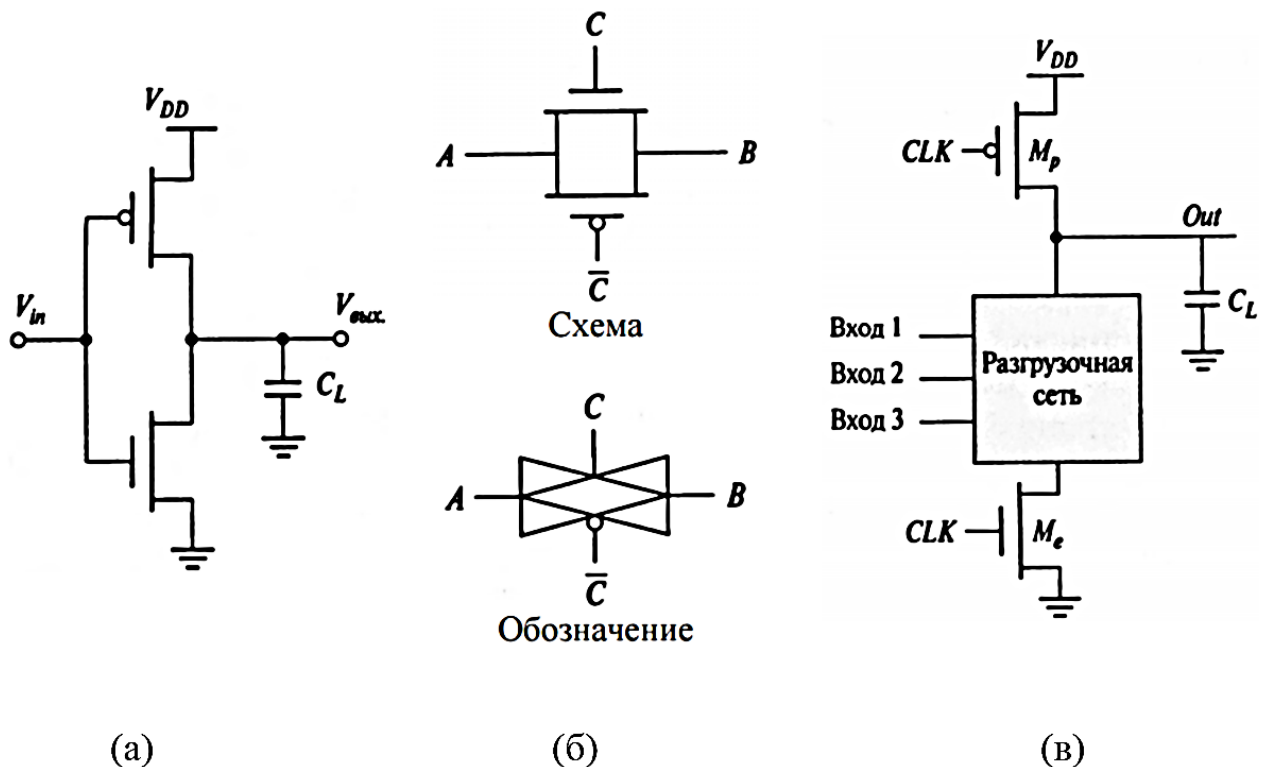


Рис. 4. Схемотехнические решения основных элементов: а) КМОП-инвертор; б) Проходной вентиль; в) Динамическая логика.

Одинаково эффективного и универсального для всех приложений LP схемотехнического базиса в настоящее время не существует. Статическая КМОП-логика и логика на проходных транзисторах эффективны при построении комбинационных схем. Динамическая логика нашла применение при построении микропроцессоров.

Использование элементов с изменяемым пороговым напряжением (VTCMOS) Технология VTCMOS используется в устройствах с низким пороговым напряжением. Используя эффект влияния подложки можно контролировать пороговое напряжение, что позволяет получить высокое V_{TH} в режиме ожидания и низкое V_{TH} в активном режиме для одного и того же транзистора. На рис. 5 приведена модификация электрической схемы КМОП-инвертора с применением технологии VTCMOS. Во время активного режима на подложку р-канального транзистора подается напряжение V_{DD} , а на подложку н-канального транзистора – $0V$, обеспечивая низкое эффективное пороговое напряжение, и, следовательно, высокое быстродействие. Во время режима ожидания на подложку р- и

п-канальных транзисторов подается напряжение $2V_{DD}$ и $-V_{DD}$ соответственно, эффективное пороговое напряжение увеличивается, уменьшая тем самым ток утечки. К недостаткам этой технологии можно отнести дополнительную схему управления смещением подложки.

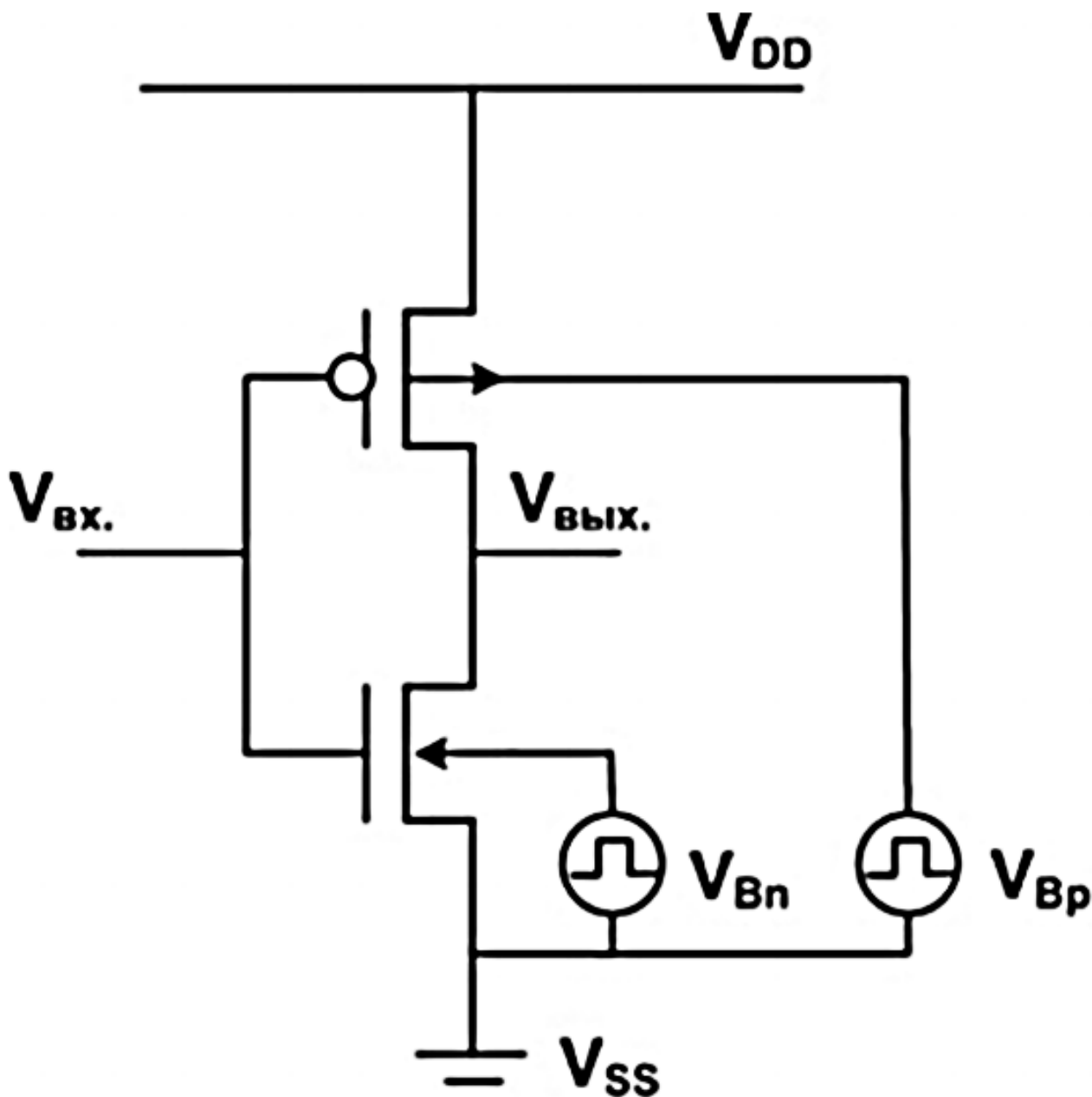


Рис. 5. Технология VTCMOS

Чтобы оценить насколько возможно снижение энергопотребления, мы рассмотрим четыре стандартных элемента: Инвертор (INV), 2И-НЕ (NAND2) и 3И-НЕ (NAND3). В результате моделирования этих элементов были получены зависимости задержки и энергопотребления от напряжения питания (Таблица 2).

Таблица 2

Зависимость энергопотребления от напряжения

V_{dd} , В	2 В		1.6 В		1.2 В	
	t_d , пс	P, мкВт	t_d , пс	P, мкВт	t_d , пс	P, мкВт
INV	64	0.34	73	0.217	84.5	0.122
NAND2	65.5	0.464	78	0.296	89	0.167
NAND3	71.8	0.59	80	0.377	95	0.212

Снижение напряжения питания приводит к снижению энергопотребления элементов. Так для инвертора (INV) при снижении напряжения питания от 2 В до 1.2 В, энергопотребление снижается на 35.8%, для 2И-НЕ (NAND2) – 35.9% и для 3И-НЕ (NAND3) -35.9 %. Таким образом среднее снижение энергопотребления всех элементов составляет 35.9%, и уменьшение быстродействия на 30%.

Список литературы

1. Угрюмов Е.П., «Цифровая схемотехника» – СПб.:БХВ-Петербург, 2004.
2. В.В. Ракитин. Интегральные схемы на КМОП-транзисторах: Учебное пособие. – М., 2007.
3. Физика полупроводниковых приборов: в 2-х кн. Кн.1 / Пер. с англ. под ред. С. Зи. – М.: Мир, 1986.
4. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники: уч. пособие. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009.